



Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0BW - 1 TB SSD - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)

256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	MZ-V7E1T0BW
EAN/UPC	8801643205300

Beschreibung

Systeme der nächsten Generation werden erst mit einer SSD so richtig schnell. Die Samsung 970 EVO bietet hohe Leistung, solide Zuverlässigkeit und eine große Auswahl an Kapazitäten. Dank modernster V-NAND Speichertechnologie, dem Phoenix-Controller sowie der Intelligent TurboWrite-Technologie befördern Sie High-End-Gaming sowie 4K Videooder 3D-Grafikbearbeitung auf ein beeindruckendes Niveau.

Diese SSD kann mehr, als Sie erwarten

Erleben Sie den Unterschied den NVMe macht! Die 970 EVO transformiert High-End-Gaming und bietet rasante Geschwindigkeit für Grafik-intensive Workflows. Der Phoenix-Controller und die Intelligent TurboWrite-Technologie machen das möglich. Die 970 EVO bietet fortschrittliche Entwicklung im Bereich von NVMe-SSDs, denn das Laufwerk bietet bis zu 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Ein Laufwerk mit so großer Speicherkapazität und geringer Abmessungen spart wertvollen Systemraum für andere Komponenten. Innovative Samsung-Technologien ermöglichen Ihnen Kapazitäten, um viel zu tun und viel zu erledigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0BW - Solid-State-Disk - 1 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Тур	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale	TRIM-Unterstützung, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperaturüberwchung, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm



Gewicht 7.94 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale	TRIM-Unterstützung, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperaturüberwchung, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T.
Breite	22.15 mm
Tiefe	80.15 mm
Höhe	2.38 mm
Gewicht	7.94 g
	Leistung
SSD-Leistung	600 TB
Interner Datendurchsatz	3400 MBps (lesen)/ 2500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	15000 IOPS
4 KB Random Write	50000 IOPS
Maximal 4 KB Random Write	450000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	500000 IOPS
	Zuverlässigkeit
MTBF	1,500,000 Stunden
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
	Stromversorgung
Energieverbrauch	6 Watt (Durchschnitt) ¦ 10 Watt (Maximum) ¦ 0.03 Watt (Inaktivität Maximum)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IEEE 1667
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen

imcopex